

シーズの名称	シリコンスピンド用デバイス技術			
シーズの特性		活用が期待される分野	製造業	
権利等の種類	特許	環境浄化	医療用	機械・器具
権利状態	他者との共有	工具	材料	IT
実施許諾実績	なし	液晶	半導体	検査装置
現状(段階)	研究開発	金型	電子部品	自動車
特許権の譲渡	不可	センサ	その他	計測装置
				光学機器
				通信機器
概要図	図. スピン注入電極構造の結晶形態を示す断面図			
(b)				
			12A:シリコンチャンネル層	
			13A:第一酸化マグネシウム膜	
			14A:第一強磁性層	
	P:シリコンチャンネル(12A)と第一強磁性層(14A)と格子整合している第一酸化マグネシウム膜の部分			
特徴	シリコンチャンネル層に室温でのスピンド用を実現する電極構造、素子またはデバイスを提案。			
独自性	シリコンチャンネル層と強磁性層の両方に格子整合している酸化マグネシウム膜が部分的に存在する構造を提案し、室温におけるスピンド用を実現する。			
サポート	実用化まで共同研究等により支援			
特許・論文等	①スピンド用電極構造、スピンド用伝導素子及びスピンド用伝導デバイス(第5651826号) ②スピンド用電極構造、スピンド用伝導素子及びスピンド用伝導デバイス(US8492809B2)			
キーワード	磁気センサー、スピンド用ランジスター、メモリー			
関連記事等	なし			
お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 共同研究推進部 TEL: 018-866-5800 Email: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp			